

03.12.2025 – 09:29 Uhr

U.S. International Trade Commission stellt Verletzung eines Patents von Infineon durch Innoscience fest

München (ots) -

- Falls diese vorläufige Entscheidung bestätigt wird, wird sie dazu führen, dass die Einfuhr der als patentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience in die USA untersagt wird
- Das Urteil ist eine weitere positive Entscheidung, die den Wert von Infineons branchenführendem Patentportfolio unterstreicht
- GaN spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Energiesysteme

Die International Trade Commission (ITC) in den USA hat die Verletzung eines Patents der Infineon Technologies AG, das sich auf Galliumnitrid-(GaN)-Technologie bezieht, durch Innoscience festgestellt.[1] Zudem bestätigte die ITC in dieser vorläufigen Entscheidung, dass beide von Infineon in dem Verfahren vor der ITC geltend gemachten Patente rechtsbeständig sind. [2] In dem anhängigen Fall geht es um die unbefugte Nutzung von Infineon-GaN-Technologien durch Innoscience. Die endgültige Entscheidung der Kommission wird am 2. April 2026 erwartet und wird, falls die vorläufige Entscheidung bestätigt wird, dazu führen, dass die Einfuhr der als patentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience in die USA untersagt wird.

„Diese Entscheidung ist ein weiterer Beleg für die Stärke des geistigen Eigentums von Infineon und bestätigt unser Engagement, unser Patentportfolio konsequent gegen Verletzungen zu verteidigen und damit einen fairen Wettbewerb im Markt sicherzustellen“, sagt Dr. Johannes Schoiswohl, Senior Vice President und Leiter der GaN Systems Business Line bei Infineon. „Wir verfolgen weiterhin das Ziel, Innovationen zu fördern und die Halbleitertechnologie weiterzuentwickeln, um die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zu adressieren – von der Dekarbonisierung bis zur digitalen Transformation.“

Die Entscheidung ist ein weiterer Schritt, der den Wert des Beitrags von Infineon zur GaN-Technologie unterstreicht. In einem parallelen Rechtsstreit in Deutschland hat das Deutsche Patent- und Markenamt vor Kurzem die Gültigkeit eines Patents von Infineon bestätigt und in leicht geänderter Form aufrechterhalten. Infineon macht die Verletzung dieses Patents vor dem Landgericht München I geltend.[3] Bereits im August 2024 stellte das Gericht die Verletzung eines weiteren Infineon-Patents durch Innoscience fest.[4]

Infineon ist ein führender Integrated Device Manufacturer (IDM) im GaN-Markt mit dem branchenweit breitesten IP-Portfolio, das rund 450 GaN-Patentfamilien umfasst. GaN spielt eine Schlüsselrolle bei der Realisierung leistungsstarker und energieeffizienter Leistungssysteme in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter erneuerbare Energiesysteme, KI-Rechenzentren, industrielle Automatisierung und Elektrofahrzeuge (EVs). Durch höhere Leistungsdichte, schnellere Schaltgeschwindigkeiten und geringere Leistungsverluste ermöglichen GaN-Halbleiter kompaktere Designs, verringern Energieverbrauch und Wärmeentwicklung. Als führendes Unternehmen im Bereich Leistungssysteme beherrscht Infineon alle drei relevanten Materialien: Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN).

[1] US 9,899,481

[2] US 9,899,481 and US 9,070,755

[3] DE102017100947

[4] DE102014113465

Pressekontakt:

Andre Tauber,
andre.tauber@infineon.com,
Tel. +49 89 343 6705

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100004630/100937000> abgerufen werden.